

GLR1202BSI-L

2K 高速线阵背照式CMOS图像传感器

GLR1202BSI-L 采用 $12.5\ \mu\text{m}(\text{H}) \times 1000\ \mu\text{m}(\text{V})$ 的长条形大像素设计，分辨率为 $2000(\text{H}) \times 1(\text{V})$ 。芯片采用背照式晶圆工艺，在 $650\ \text{nm}$ 波长下量子效率近90%。芯片最大满阱为 $2\ \text{Me}^-$ ，可提供 $69\ \text{dB}$ 的动态范围。基于应用需求，用户可切换到高增益工作模式来实现更低的读出噪声。芯片支持片上 1×2 binning功能，在实现灵敏度翻倍的同时将最大行频提升到 $350\ \text{kHz}$ 。封装采用CLCC陶封，搭配有双面抗反射镀膜的玻璃密封。



产品特性

- ▶ 高 QE
- ▶ 1x2 Binning
- ▶ 高行频 240 kHz
- ▶ 像素尺寸 $12.5\ \mu\text{m} \times 1000\ \mu\text{m}$

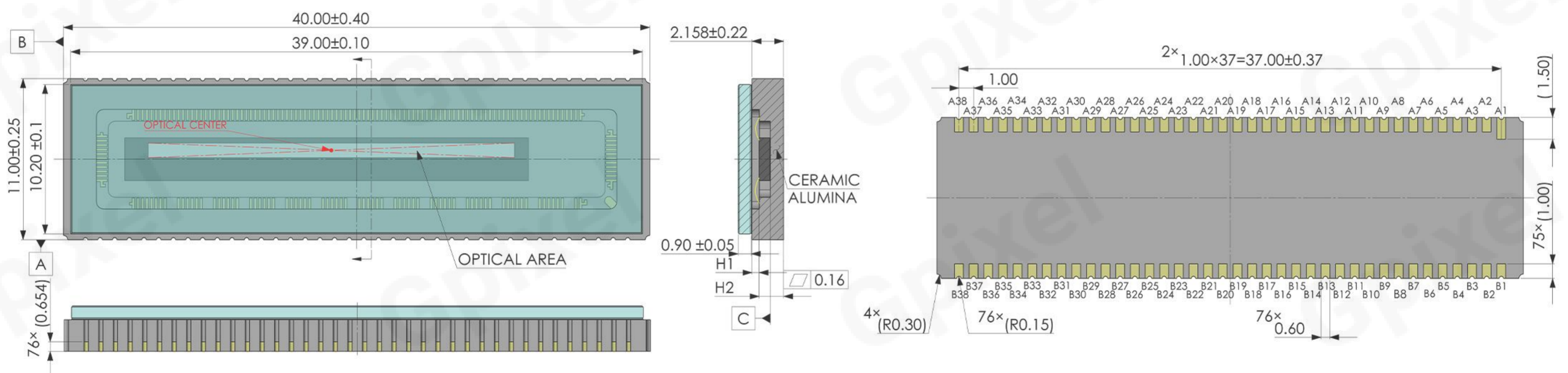
应用领域

- ▶ 工业检测
- ▶ 工业测量
- ▶ 光谱分析

产品指标

有效分辨率	2000 (H) x 1 (V)	感光面长度	25 mm
像素尺寸	12.5 μm x 1000 μm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	91 % (440 nm)	读出噪声	675 e ⁻ (LG) 215 e ⁻ (HG)
满阱容量	2 Me ⁻ (LG) 0.18 Me ⁻ (HG)	暗电流	T.B.D
动态范围	69 dB (LG) 58 dB (HG)	最高行频	240 kHz 350 kHz (1x2 binning)
输出接口	5x Sub-LVDS	最大信噪比	63 dB
ADC	12 bit	最大数据率	6 Gbps
色彩	黑白	功耗	< 500 mW
供电电压	3.3 V (模拟) 1.5 V (数字) 1.8 V (IO)	封装形式	76 pins CLCC (40 mm x 11 mm)

封装信息



联系方式

长春 (总部)

长春长光辰芯微电子股份有限公司
吉林省长春市经开区自由大路7691号
光电信息产业园一期1号、5号办公楼
电话: 0431-85077785

杭州

杭州长光辰芯微电子股份有限公司
浙江省杭州市滨江区建业路599号
华业发展中心31楼3101-3109室
电话: 0571-87718606

大连

大连长光辰芯微电子股份有限公司
辽宁省大连市高新技术产业区
汇贤园7号11楼05D室
电话: 0411-39937666



免责声明: 本彩页所涉及的产品信息及图片仅供参考, 由于产品不断更新, 最终请以实物为准。长光辰芯保留本产品彩页的最终解释、修订权利。
GP-PR260521 V1.0

✉ info@gpixel.com

🌐 www.gpixel.com